

## 硅和蓝宝石基底上的高T<sub>c</sub>薄膜(英文)

贾米尔·温纳毕[1], 艾斯法塔赫尔[2], 哈希米R A[3]

( [1] 古拉姆-伊夏克-克汗工程科学与技术学院工程科学系, Topi-23460, N. W. F. P. , 巴基斯坦;; [2] 卡拉奇大学物理系凝聚态材料实验室, 卡拉奇, 巴基斯坦;; [3] 吉纳女子大学, 卡拉奇74600, 巴基斯坦 )

中图分类号: 0511.4

**摘要:** 使用多层沉积和大块沉积两种技术, 在硅和蓝宝石的单晶基底上沉积了Yba<sub>2</sub>XCu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>高T<sub>c</sub>薄膜. 实验显示: 在硅基底上得到了转变温度为80K的期待结果.

**关键词:** 高T<sub>c</sub>薄膜;; Yba<sub>2</sub>XCu<sub>3</sub>O<sub>7</sub>;; 单晶基底;; 沉积技术

 [阅读文章\(pdf\)](#)

关闭本页